2002 - 0032855

	(19) (12)			(KR) (A)	
(51) 。Int. CI. <sup>7</sup> G02F 1/136				(11) (43)	2002 - 0032855 2002 05 04
(21) (22)	10 - 2000 - 0063568 2000 10 27				
(71)		20			
(72)			302		
(74)					
(54)					

6

- 1 -

1								
2								
3	2	- ′						
4								
5	4	- '						
6								
7a	7b							
				,				
				,	가			
				(transmiss	ion type)	(reflect	ion type)	
						klight)		
(pov	wer consi	umption)가	,		¬.			
					기	•		
, 가	가							
,								
1								
				,			(40)	
1		,		(	)		(10)	

- 2 -

```
, (30) (41) 가
(20)
                         (30)
                         (20) ITO(indium - tin - oxide) IZO(indium - zinc - oxide)
40)
                                         (40) (AI)
      (10)
                     (10)
                                               (50)
                                                                      (50)
      (R), (G), (B)
                                            (60)가
                     가
                                                              가
   (60)
                                        (60)
     (60)
                ITO
                     IZO
                                                    (70)
   , (50)
                     (10)
                                    (80)
   (10, 50)
                                                                (91, 92)
                            (91)
                                         (92)
                                    (92)
                                                        (91)
                                                                        90
   가 .
                                (91)
                                                 (100)가
           (91)
                                     가 가
              가
                                                                        가
       가
                                                             가
                                                          (Cr)
                                                                     (AI),
                                 가
```

- 3 -

3 2 (110) 2 3 가 (121) (121) (121) (122)(122) (SiNx)  $(SiO_2)$ (130) (130) (151), (152) (140)(151) (152), (121) (122)(153) (152, 153) (140) (160) , (152, 153) (152, 153) , (160) (153) , (160) BCB(benzocyclobutene) , (160) ITO IZO (170) (170) (161) 170) (151) (153) (160) BCB (170) (170)(170) (SiNx) ) 5 5 4 (210)(220)가 (220)가 (220) (230)(220) (230) (220) (Cr) (AI) (220)(230)(220) (R), (G), (B) (240)가 (240) ITO IZO (250)6 6 5 3 (300)가 (220) (230)가 (220)(230)

- 4 -

, 7a 7b 5 7a (210) (220) (230) (220) (230) (220)3 (230) (220) (230)(220) 가 (240)7b ITO (250)5 (230)(230)(220) 6 170) (230)가 가 (57) 1.

- 5 -

;

•

2.

1 ,

3.

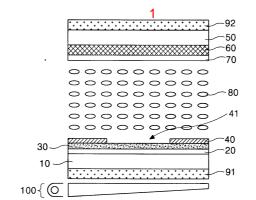
2 ,

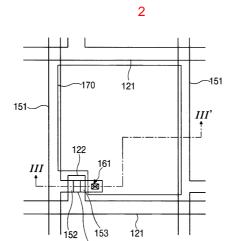
(Cr) (AI),

4.

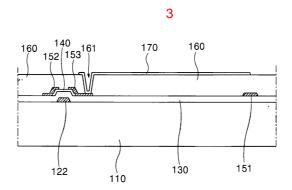
1 ,

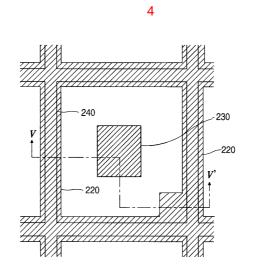
, , " | " .

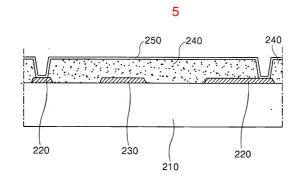


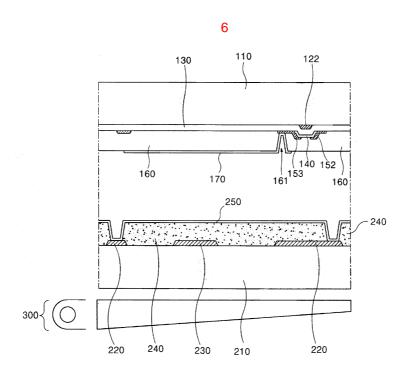


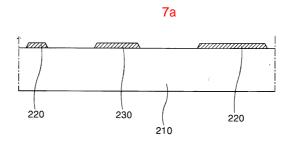
153 140

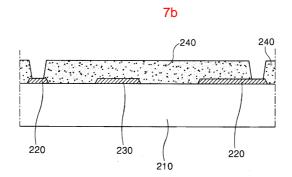














专利名称(译)	透反液晶显示器及其制造方法		
公开(公告)号	KR1020020032855A	公开(公告)日	2002-05-04
申请号	KR1020000063568	申请日	2000-10-27
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	KIM HONG JIN		
发明人	KIM,HONG JIN		
IPC分类号	G02F1/136		
代理人(译)	贞媛KI		
外部链接	Espacenet		

## 摘要(译)

在用于选择性地使用反射模式和透明模式的半透射液晶显示器中,由于分别对反射电极和透射电极进行图案化,所以工艺数量增加。并且,在上部形成的电极的图案化中,蚀刻剂可以侵蚀下部的电极。在根据本发明的半透射型液晶显示器中,传输电极形成在包括薄膜晶体管的基板上。在包括滤色器的基板上将反射器形成为类似黑色矩阵的材料之后,滤色器基板布置在下部,并且薄膜晶体管基板布置在上部。随后,通过在滤色器基板的下部布置背光源,液晶层在完成形成之后减少了工艺数量,并且防止了在双板之间电极的腐蚀。此外,由于黑色矩阵像反射器一样反射光,所以增加了反射模式的效率。半透射,反射电极,反射器,工艺数量。

